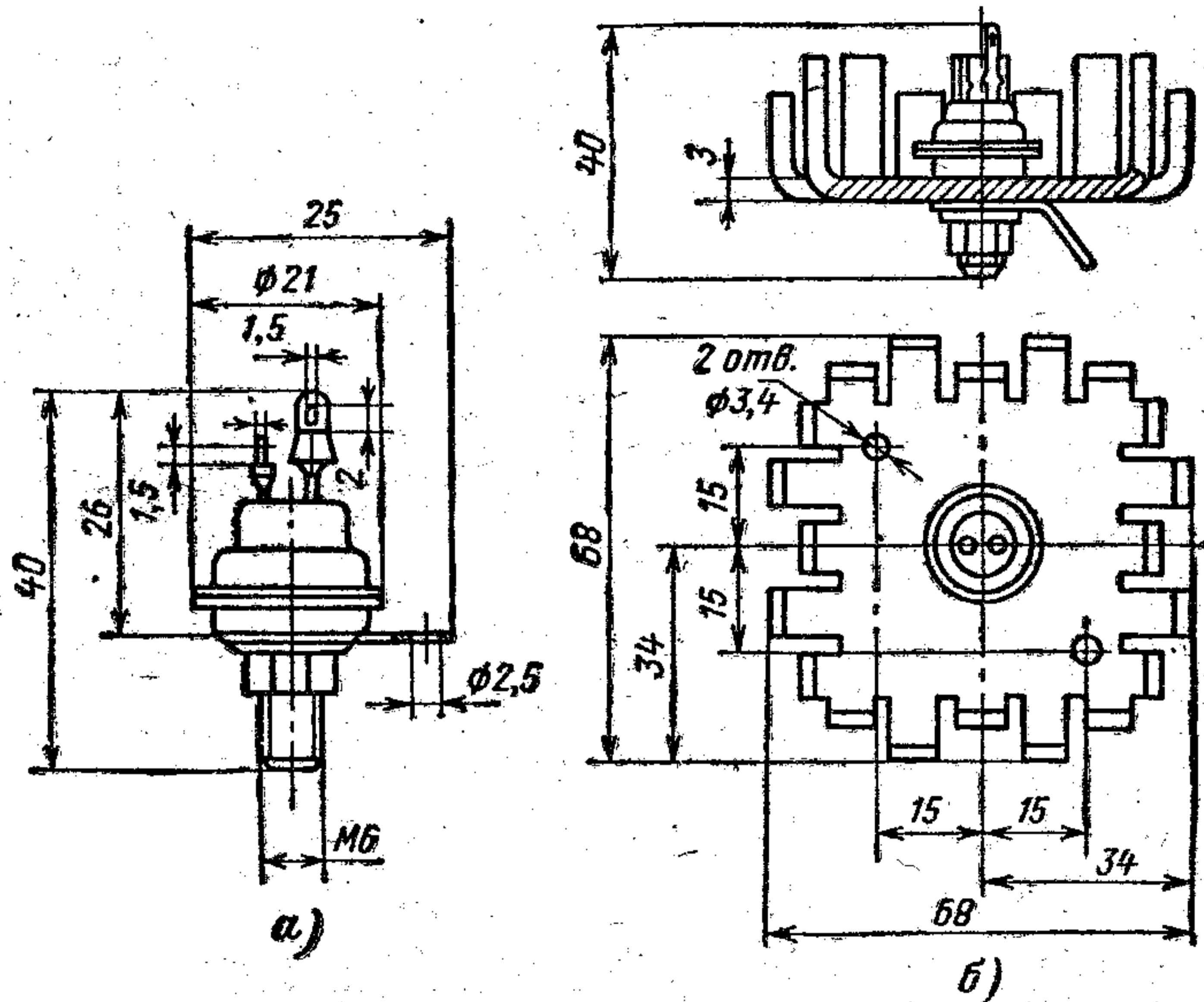
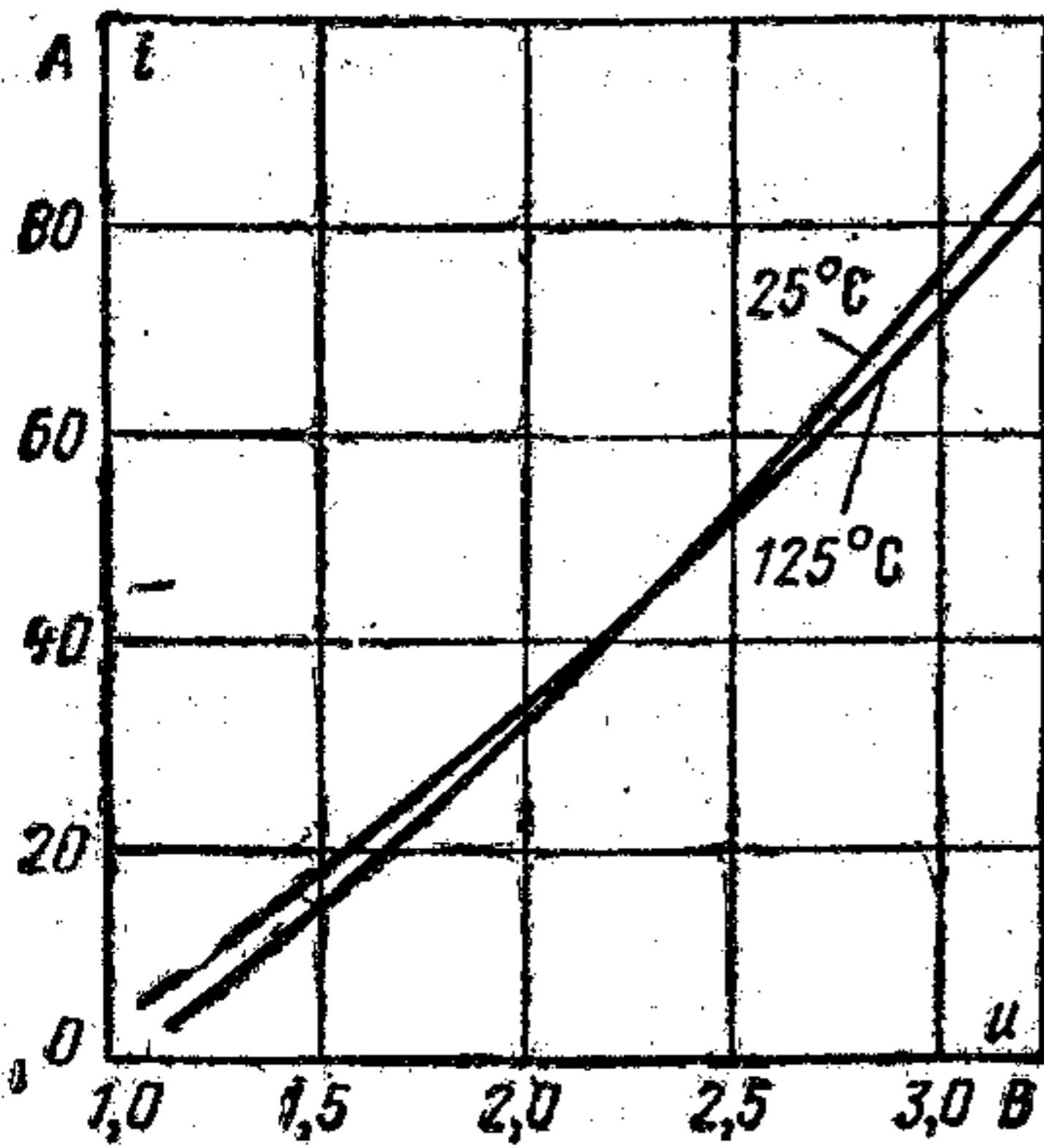


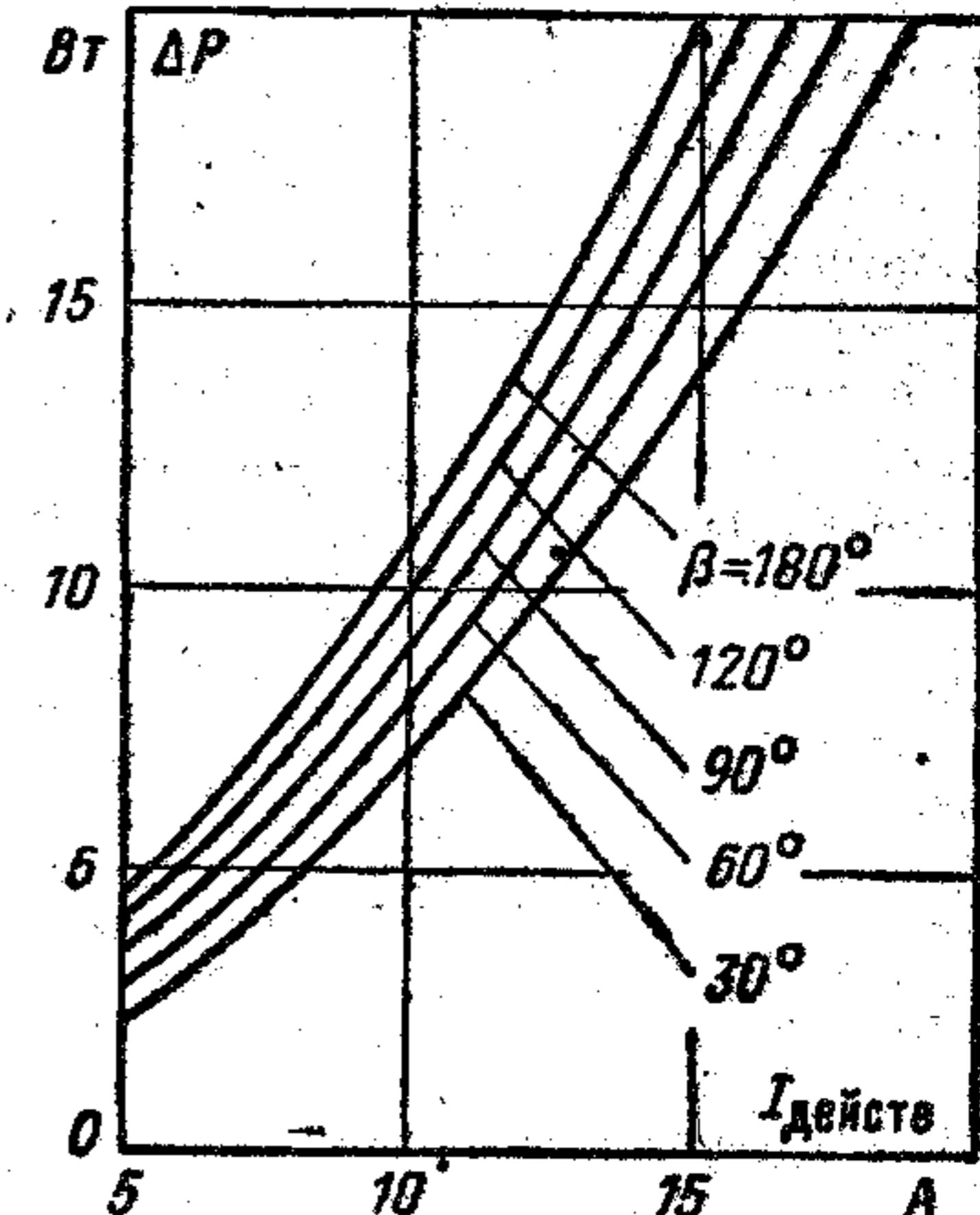
Симисторы типа ТС10 (ТУ 16.529.609-71) предназначены для работы в бесконтактной коммутационной и регулирующей аппаратуре



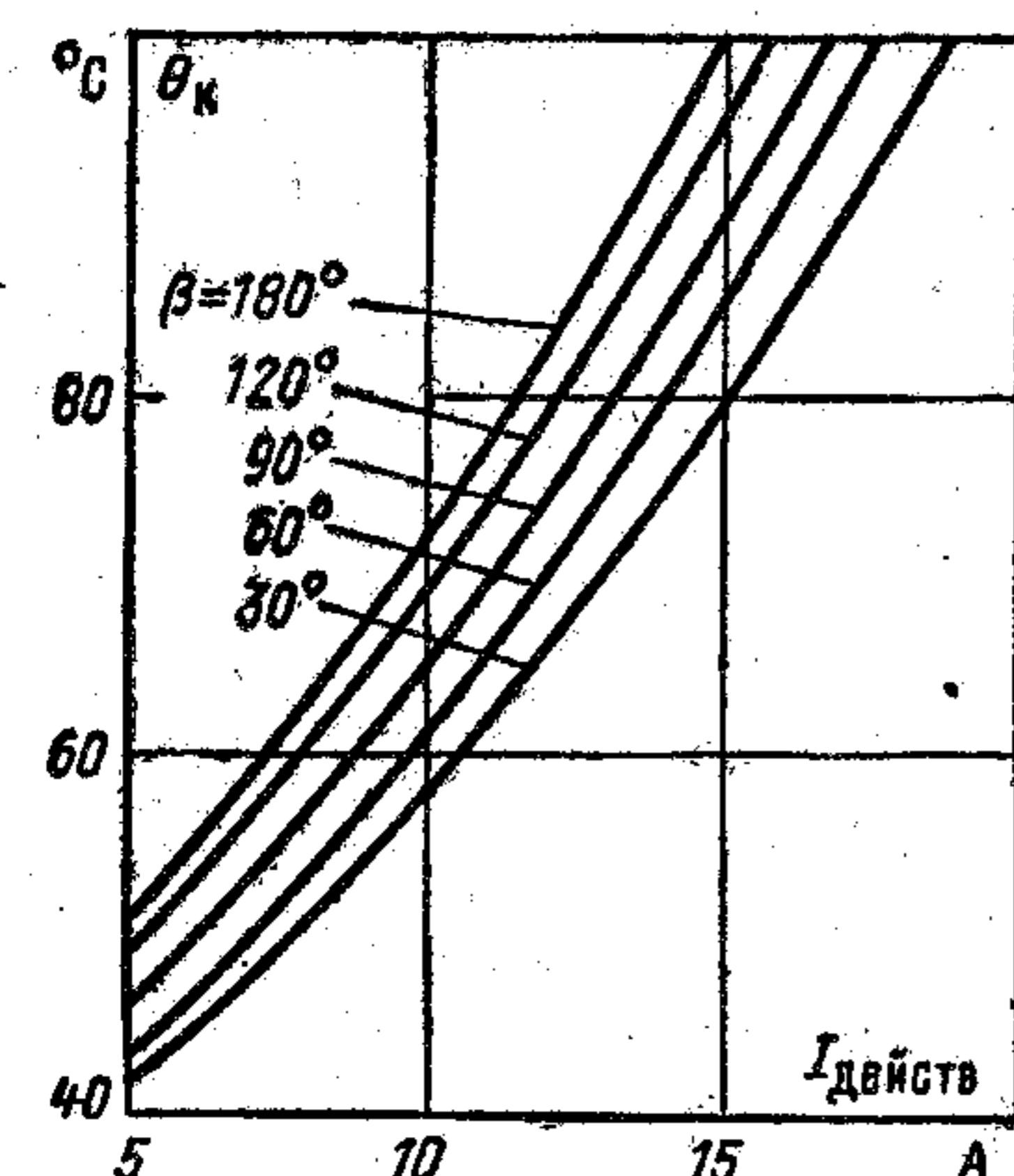
Габаритные и установочные размеры симистора ТС10 без охладителя (а) и с охладителем (б).



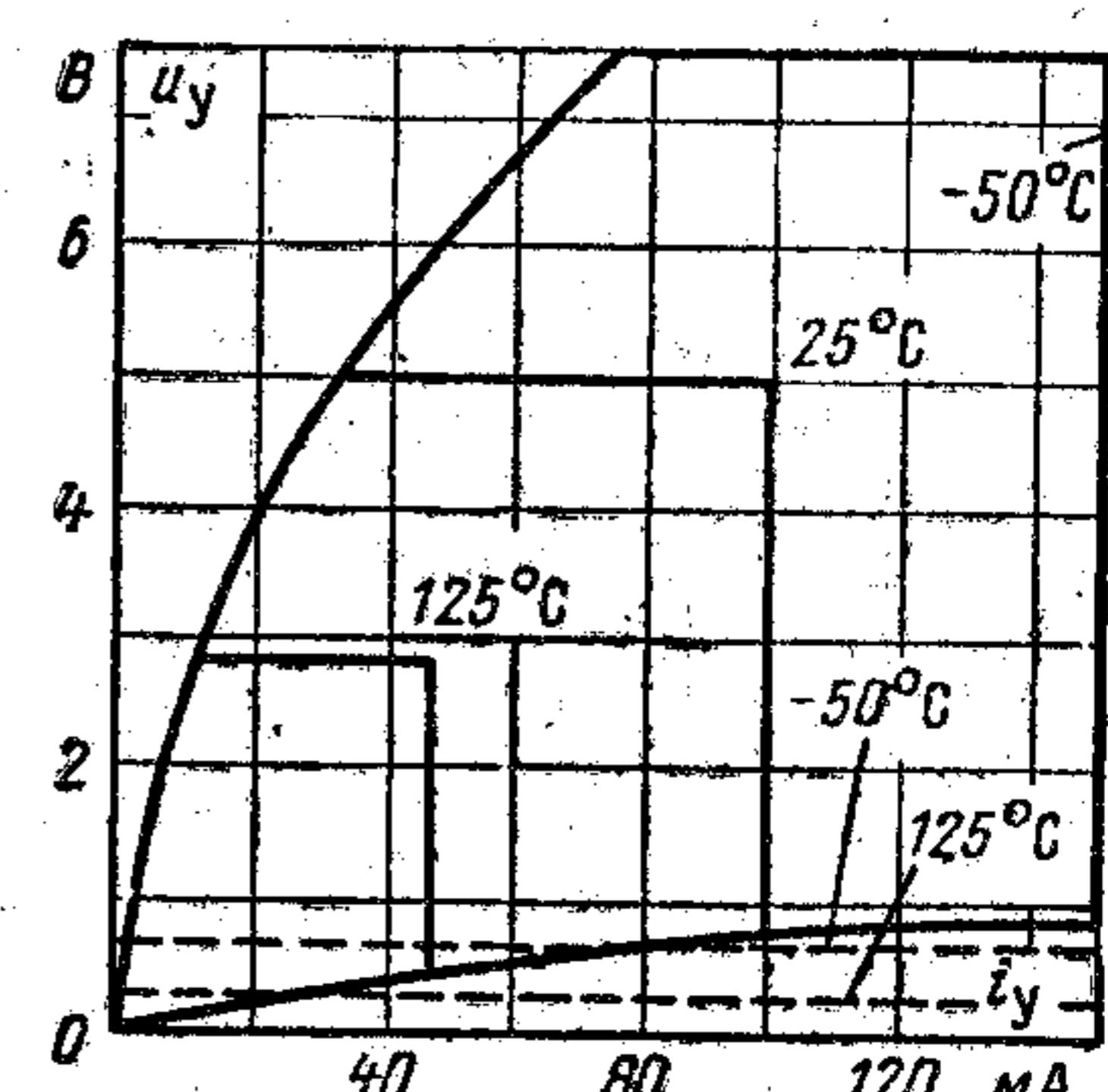
Предельные прямые вольт-амперные характеристики симистров ТС10 в открытом состоянии.



Зависимость мощности потерь ΔP в открытом состоянии от действующего значения тока $I_{\text{действ}}$ при различных углах проводимости θ для синусоидальной формы тока симисторов ТС10.



Зависимость максимально допустимого действующего значения тока $I_{\text{действ}}$ от температуры корпуса θ_K при различных углах проводимости β для синусоидальной формы тока симисторов ТС10.

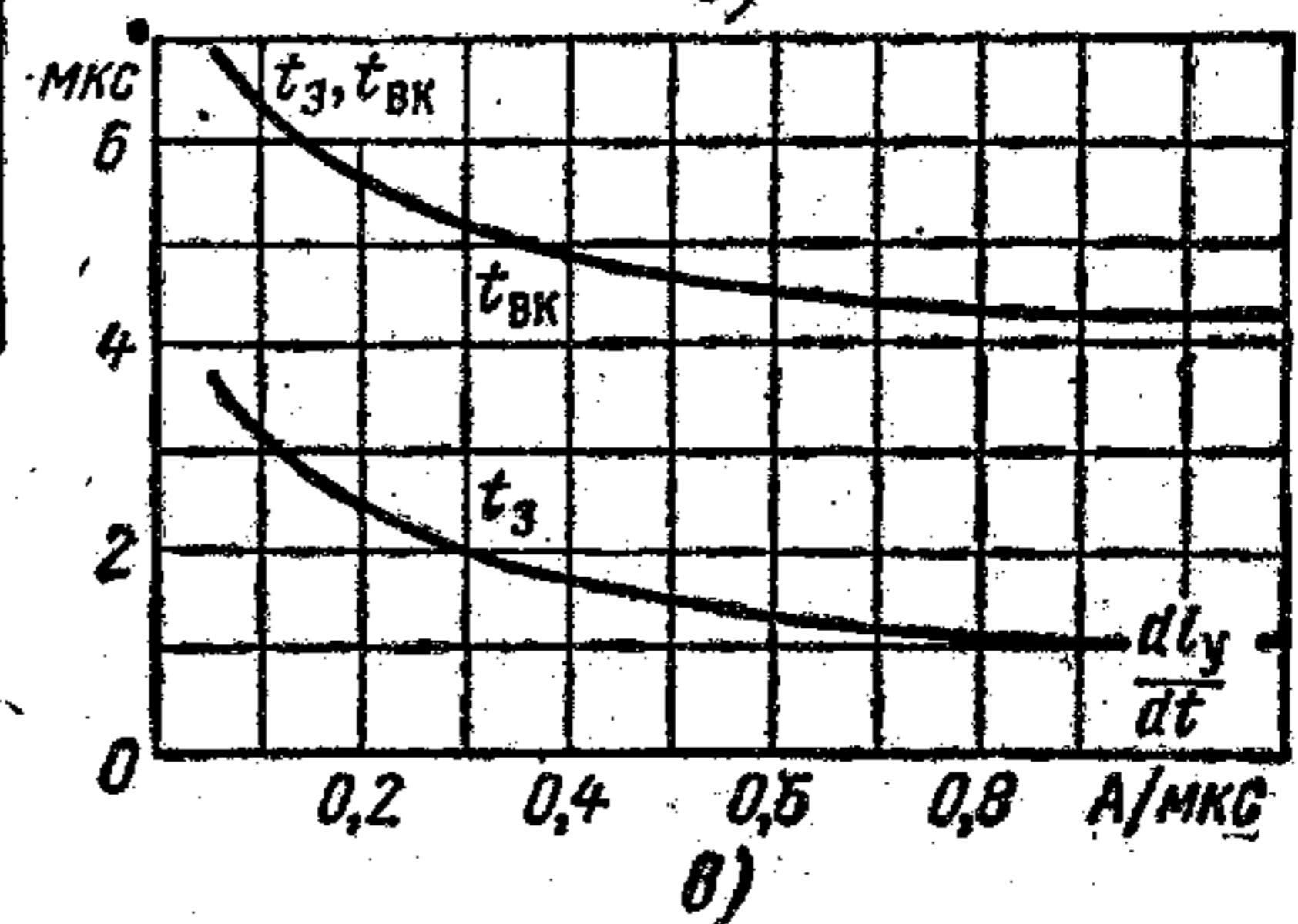
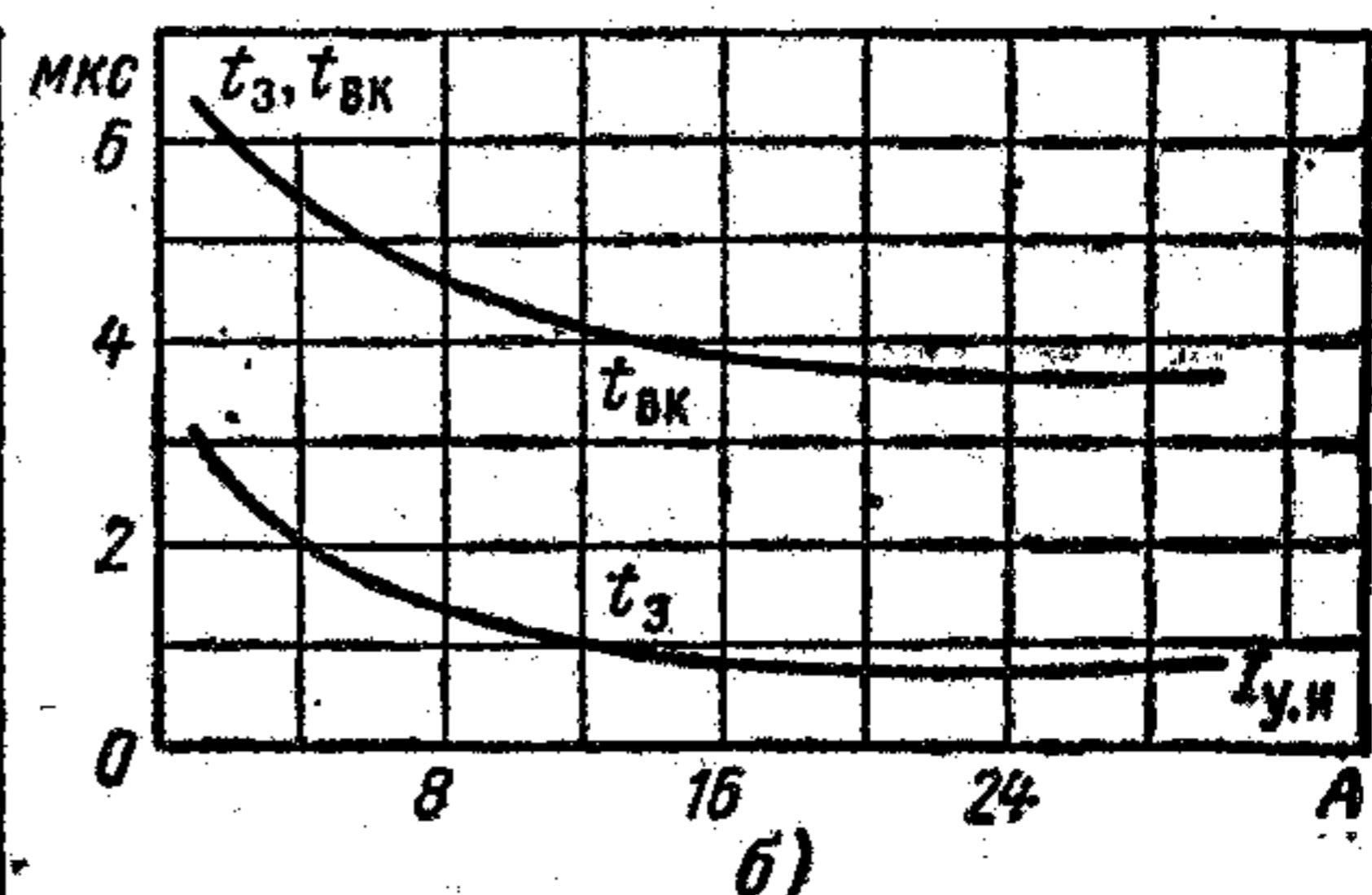
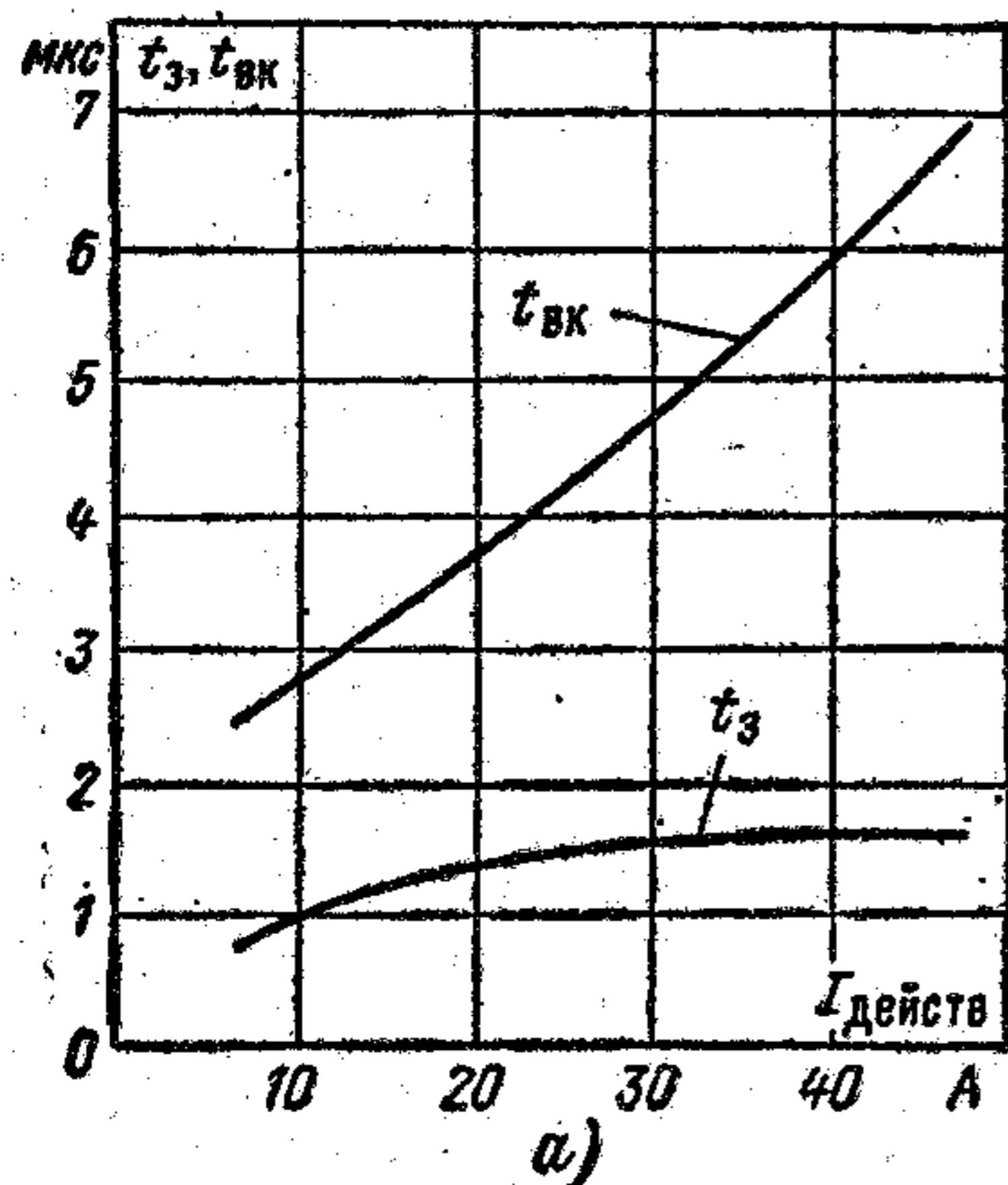
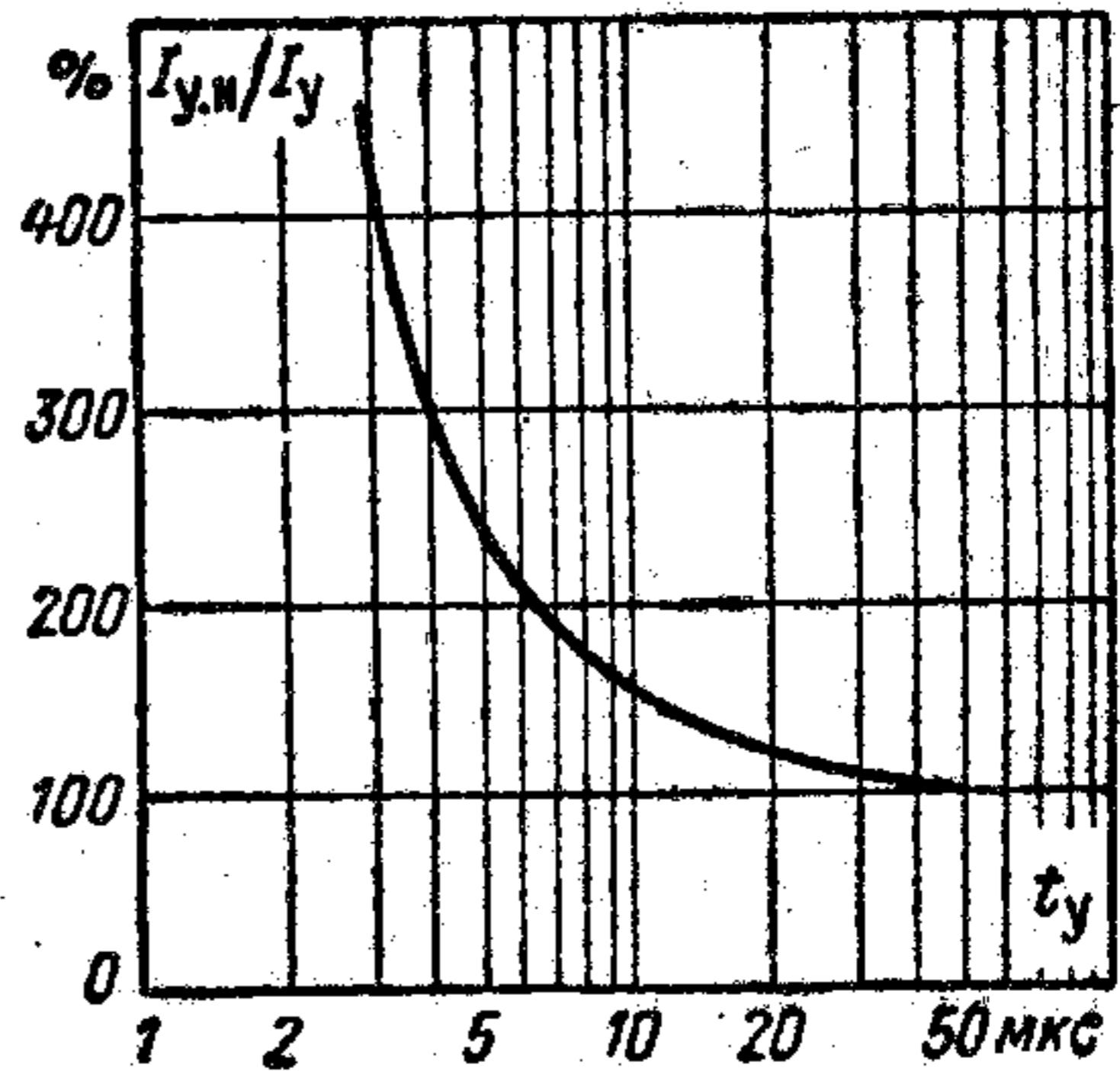


Предельные характеристики управления симисторов ТС10.

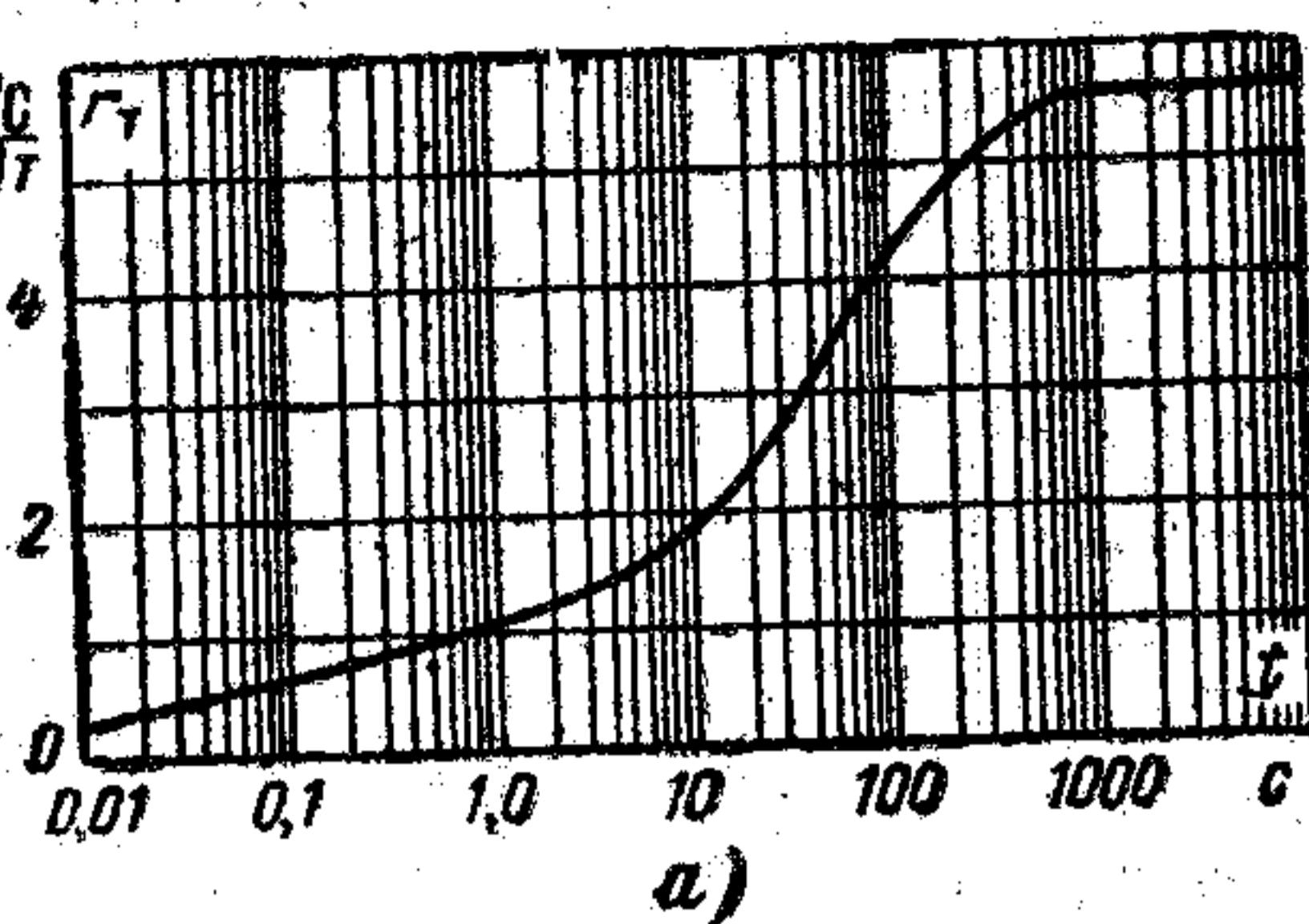
в цепях переменного тока частоты 50 Гц с естественным воздушным охлаждением в условиях:

температуры окружающей среды от -50 до $+125^{\circ}\text{C}$;
вибраций в диапазоне частот 5—80 Гц с ускорением 75 м/с^2 ,
ударных сотрясений с ускорением 120 м/с^2 .

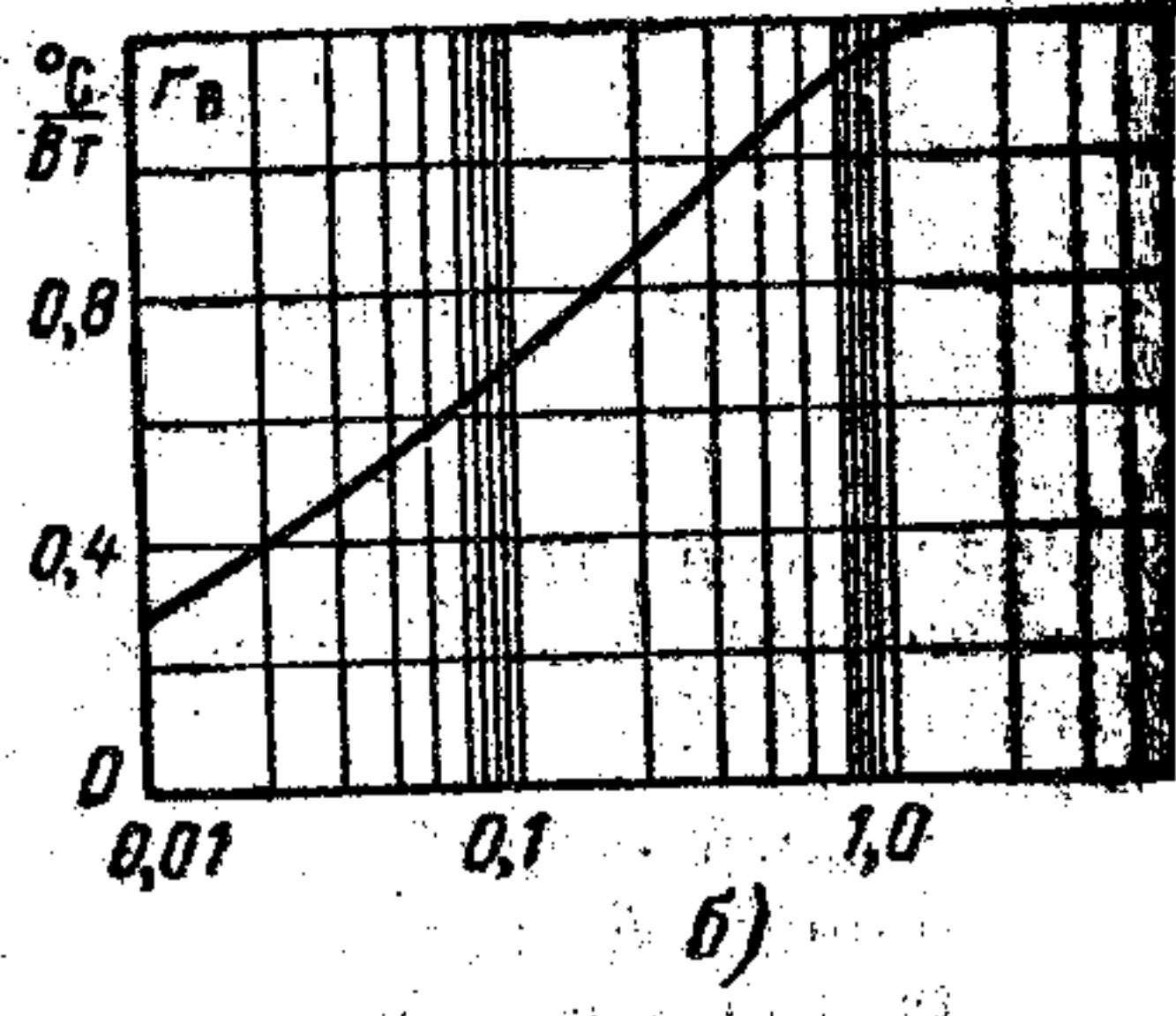
Зависимость амплитуды отпирающего тока управления $I_{y.\text{и}}$ (в процентах к отпирающему постоянному току) от длительности управляемого импульса t_y симисторов ТС10.



Типичные зависимости времени задержки t_3 и времени включения t_{vk} от тока $I_{\text{действ}}$ (а), амплитуды импульса управления $I_{y.\text{i}}$ (б) (по отношению к отпирающему постоянному току I_y) и скорости нарастания тока управления dI_y/dt (в) симисторов ТС10.

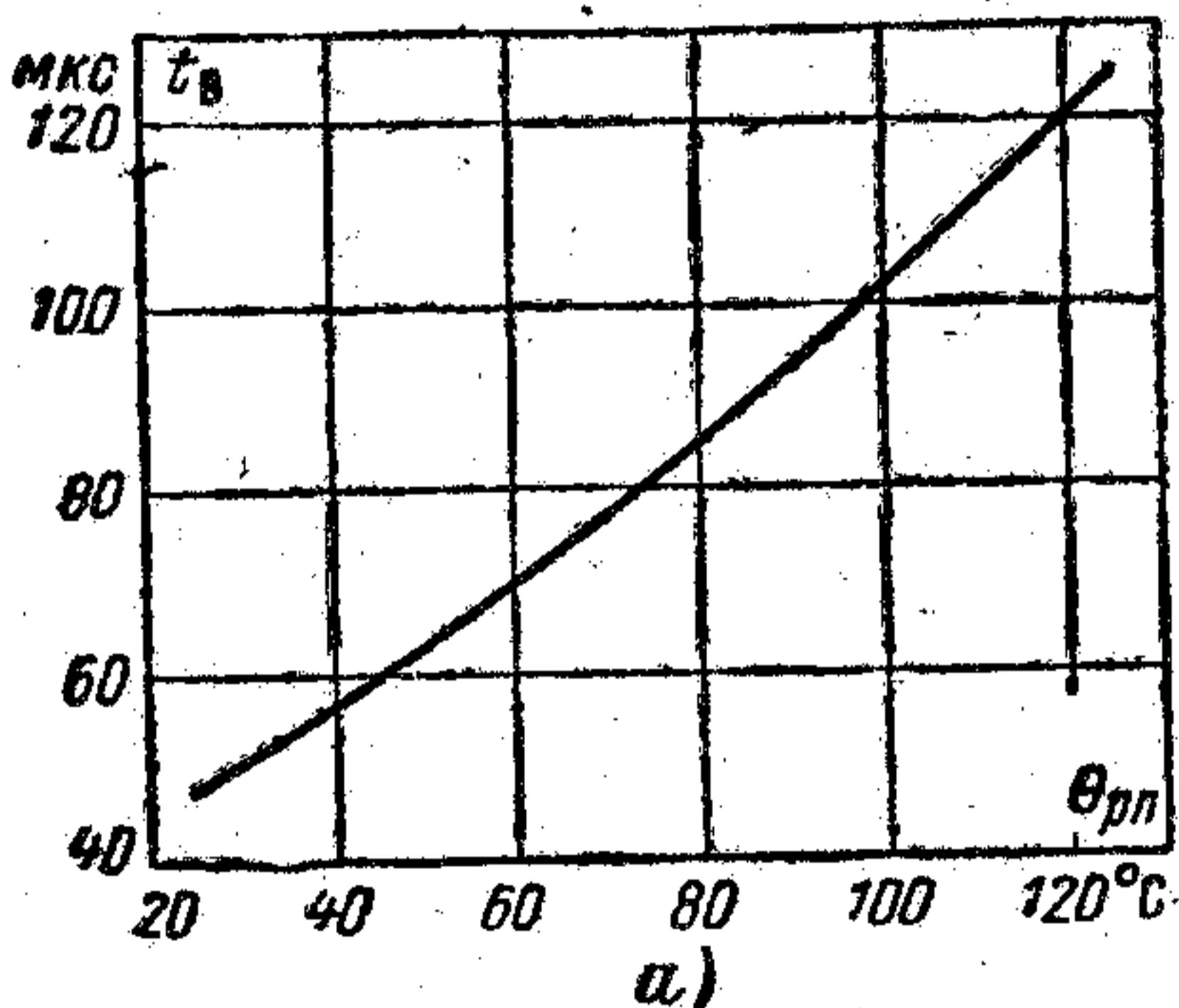


a)

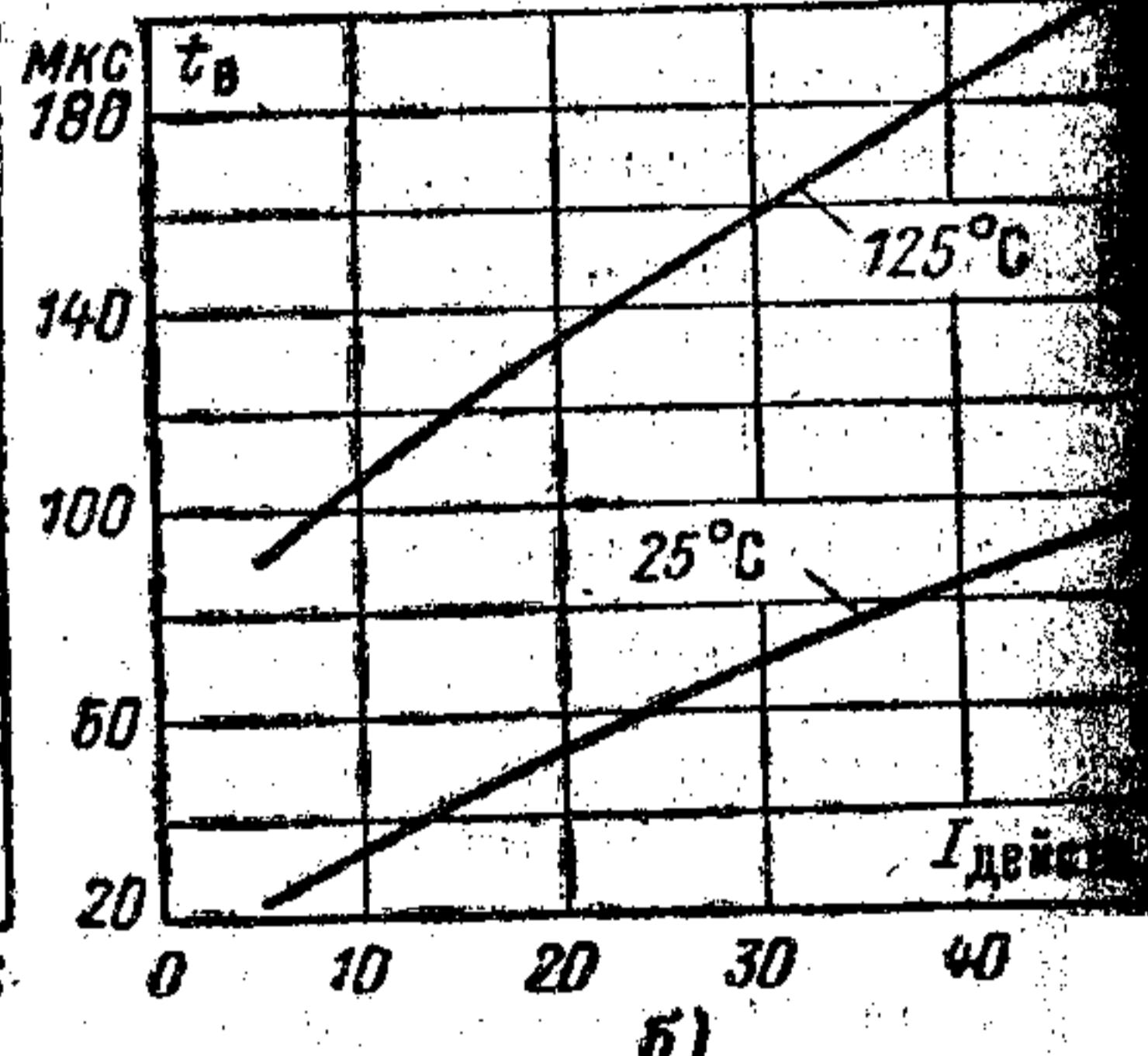


b)

Общее r_T (а) и внутреннее r_B (б) переходные тепловые сопротивления симисторов ТС10.

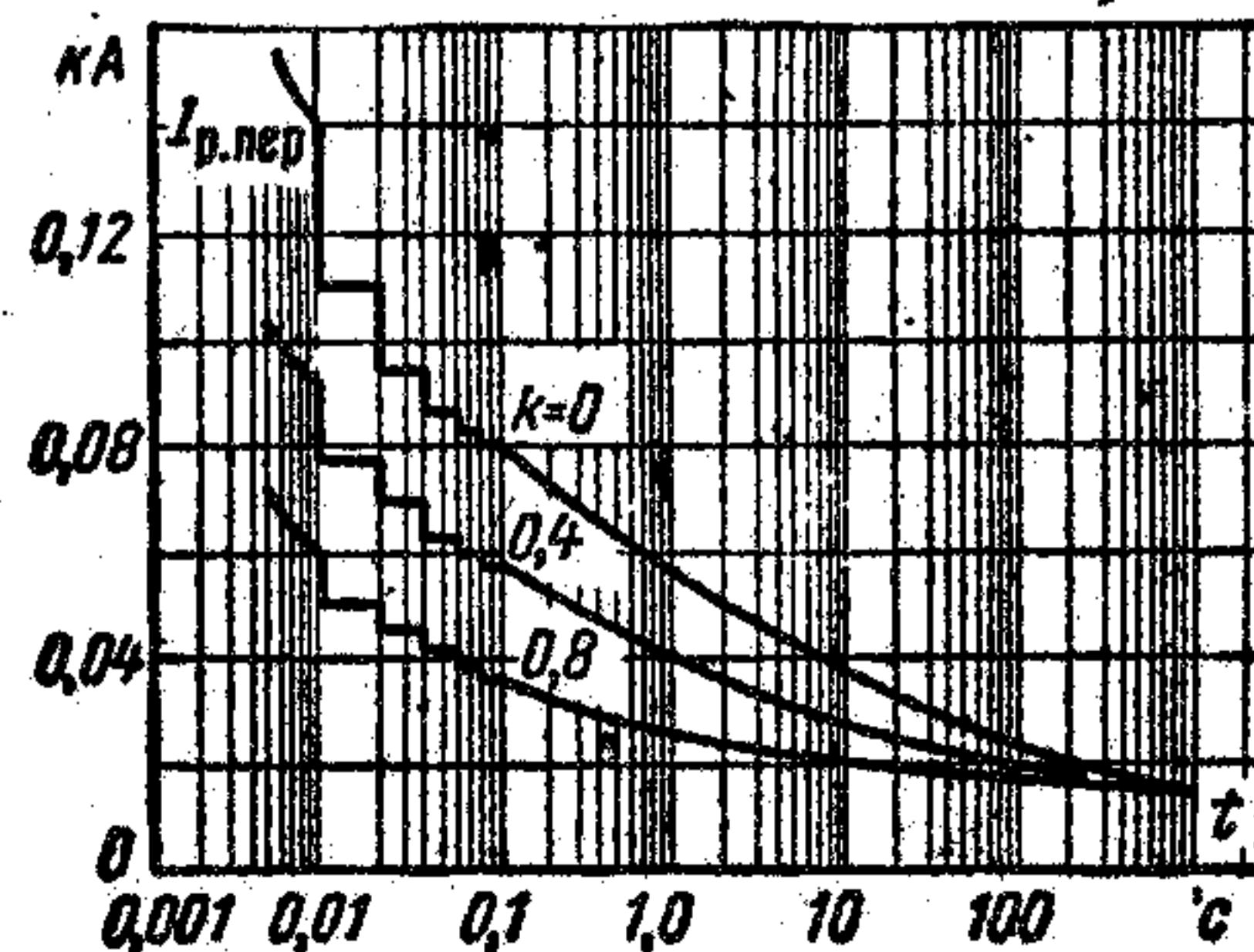


a)



б)

Зависимость времени выключения t_B от температуры структуры θ_{pn} (а) и тока нагрузки $I_{\text{действ}}$ (б) симисторов ТС10.



Зависимость максимально допустимой амплитуды тока бочей перегрузки $I_{\text{р.пер}}$ от длительности t (k — отношение действующего значения тока предельной нагрузки к предельному действующему значению) симисторов ТС10.

Параметры симисторов ТС10

| Параметр | Значение |
|---|----------------------|
| Предельный ток $I_{п.к}$ (действующее значение), А, при температуре корпуса 100°C | 15 |
| Предельный ток $I_{п.о}$ (действующее значение), А, при естественном охлаждении и температуре охлаждающего воздуха 40°C (с типовым охладителем) | 12 |
| Предельный ток $I_{п.о}$ (действующее значение) А, при естественном охлаждении и температуре охлаждающего воздуха 40°C (без охладителя) | 3 |
| Ток утечки $I_{ут}$ при $\theta_{pn}=125^{\circ}\text{C}$, мА (амплитудное значение), не более | 3 |
| Прямое падение напряжения u , В (амплитудное значение), при токе, равном $12\sqrt{2}$ А, и температуре 25°C | 1,5 |
| Пороговое напряжение U_0 , В | 1,0 |
| Динамическое сопротивление R_d , Ом | $2,94 \cdot 10^{-2}$ |
| Отпирающий ток управления I_y , мА, при температуре 25°C и $U=12$ В, не более | 100 |
| Отпирающее напряжение управления U_y , В, при температуре 25°C и $U=12$ В, не более | 5 |
| Неотпирающее напряжение управления $U_{y.н}$, В, при $\theta_{pn}=125^{\circ}\text{C}$, не менее | 0,3 |
| Неотпирающий ток управления $I_{y.н}$, мА, при $\theta_{pn}=125^{\circ}\text{C}$, не менее | 1 |
| Ток удержания $I_{удерж}$, мА | 30 |
| Время включения $t_{вк}$, мкс ($\theta_{pn}=25^{\circ}\text{C}$; $U_{отп}=100$ В; $I_y=1$ А; $di/dt=1$ А/мкс; $I_{отп}=I_{п.к}$), не более | 12 |
| Время выключения $t_{в}$, мкс ($\theta_{pn}=125^{\circ}\text{C}$; $I_{отп}=I_{п.к}$; $U_{отп}=U_u$; $di/dt=5$ А/мкс; $du/dt=10$ В/мкс), не более | 200 |
| Внутреннее установившееся тепловое сопротивление R_b , $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более | 1,2 |

| | |
|---|----------------|
| Критическая скорость нарастания прямого напряжения $(du/dt)_{\text{кр}}$, В/мкс ($\theta_{pn} = 125^\circ\text{C}$; $U_{\text{отп}} = 0,67 U_{\text{пп}}$), не более | 10 |
| Критическая скорость нарастания коммутирующего напряжения $(du/dt)_{\text{кр}}$, В/мкс, при $\theta_{pn} = 125^\circ\text{C}$, не менее | 1 |
| Критическая скорость нарастания тока $(di/dt)_{\text{кр}}$, А/мкс, ($\theta_{pn} = 125^\circ\text{C}$; $I_{\text{отп}} = 17 \text{ A}$; $f = 50 \text{ Гц}$; $I_y = 0,3 \text{ A}$; $di_y/dt = 1 \text{ A/мкс}$), не более | 10 |
| Ударный ток $I_{\text{уд}}$, А, при длительности 20 мс и температуре структуры, $^\circ\text{C}$: | |
| 25 | 110 |
| 125 | 70 |
| Максимально допустимая температура структуры, $^\circ\text{C}$ | 125 |
| Масса симистора (без охладителя), г | $10,5 \pm 0,5$ |
| Закручивающий момент при соединении симистора с охладителем, Н·м | 2,45 |